X線照射による MoS2の結晶相転移機構解明に向けた研究

Towards the Mechanism of Crystal Phase Transition of MoS_2 Under X-ray Irradiation

東大院工¹, 宇宙研²⁰谷澤 涼太^{1,2}, 小林 大輔², 廣瀬 和之^{1,2}

UTokyo¹, ISAS² ^ORyota Tanizawa^{1,2}, Daisuke Kobayashi², and Kazuyuki Hirose^{1,2}

E-mail: ryota-tani18@g.ecc.u-tokyo.ac.jp, hirose@isas.jaxa.jp

[はじめに] MoS₂ 2H 相は半導体で広いバンドギャップ、化学的安定性、耐熱性等を有しており、また Si と比べて薄膜化による移動度の減少が緩和されることから、MOSFET 応用への関心が高まっている。一方、MoS₂ 1T 相は金属で、2H 相の 10⁷ 倍以上の伝導率を有することが報告されており、その様々な性質から触媒、スーパーキャパシタ、バッテリー、センサー等多くの分野における応用が期待されている [1]。1T 相の作製方法の 1 つとして、自然界で存在する 2H 相を相転移させる方法がある。相転移の手法として、単層 MoS₂ (0.65 nm)/SiO₂に対する電子線照射 [2]や、バルク MoS₂ (3 nm)/SiO₂(400 nm)/Si に対する X 線照射[3]などが報告されているが、いまだ相転移のメカニズムは解明されていない。メカニズムを解明して相転移が起きる有効な条件を見出すことは、1T-MoS₂ の作製のために必要である。そこで、本研究では X 線照射による MoS₂ の結晶相転移に着目し、相転移のメカニズムの解明を目指した。

[実験] MoS₂(3 nm)/SiO₂(400 nm)/Si 試料に X 線を照射して相転移が確認された際の XPS スペクトルの、2H /1T 相の Mo 3d ピークの半値幅とピーク結合エネルギーのシフトについて、詳細に評価した。さらに、MoS₂単結晶をスコッチテープで剥離して作成した下地のない MoS₂薄膜に X 線を照射することで相転移に対する下地 SiO₂ 層の影響を検討した。

[結果と考察] 解析結果より、X線照射時間 とともに 1T 相割合は増加することが確認で きた。Fig. 1, 2 に半値幅 (FWHM) の時間変 化とピーク結合エネルギーのシフトをそれぞ れ示す。Fig.1より半値幅は、2H相(青丸) では1時間から10時間において減少し、10 時間から 40 時間においてほぼ一定であるこ とが分かり、1T相(橙丸)では照射後1時間 から21時間において大きくなっていき、21 時間から40時間においてほぼ一定である。 このことから、2H 相では膜中の電界は照射 後1時間から10時間において小さくなって いき、10時間から40時間においてほぼ一定 であること、一方 1T 相では膜中の電界は照 射後1時間から21時間において大きくなっ ていき、21時間から40時間においてほぼー 定であることが考えられる。また Fig. 2 か ら、2H 相(青丸)は下地の SiO₂ (Si ピーク 灰丸)よりピークシフトが大きく、1T相(橙 丸)は SiO2よりピークシフトが小さいこと が分かる。この結果に Fig. 1 の考察を加味す ると、2H 相は時間とともに、2H 相の SiO₂ 下地側の界面に、界面ダイポールが増大した 可能性、一方 1T 相は時間とともに負に帯電 した可能性が示唆される。



Fig. 1. Dependence of full width at half maximum (FWHM) of the Mo 3d peak on X-ray irradiation.



Fig. 2. Shift of peak binding energy of Mo 3d peak with X-ray irradiation time.

さらに、SiO₂下地がない MoS₂薄膜 (~3.2 nm) に対して 8 時間 X 線を照射し続けたが、相転移は確認されなかった。この結果より、相転移を生じさせるためには、SiO₂下地が必要であることが示唆される。したがって、2H/SiO₂界面が相転移の起点になっていると考えられる。そこで、①2H/1T 構造と②1T/2H 構造の電界分布を計算して、Fig. 1,2 を再現するのは①2H/1T 構造であることの確認を進めている。この結果も用いて当日議論したい。

[参考文献] [1] Jayabal, *Materials Today Energy*, **10**, 264 (2018). [2] Lin, *Nat. Nanotechnol.*, **9**, 391 (2014). [3] Matsuzawa, *JSAP Spring Meeting* (2021).